

## ИЗУЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО РЕЖИМА ГЕНЕРАЦИИ В НЕПОЛОСКОВЫХ ИНЖЕКЦИОННЫХ ЛАЗЕРАХ НА ОСНОВЕ InGaAsP/InP ПРИ 300 К

А.Е. Дракин, П.Г. Елисеев, Б.Н. Свердлов

УДК 621.378.325

*Впервые получена непрерывная генерация при 300 К в неполосковых лазерных диодах на основе гетероструктур с трехслойным волноводом в диапазоне длин волн 1,38 – 1,40 мкм.*

В последнее время за счет уменьшения толщины активного слоя и применения трехслойного волновода в гетероструктуре на основе InGaAsP/InP /1/ достигнуто снижение пороговой плотности тока до  $\sim 0,5$  кА/см<sup>2</sup>. Благодаря этому стало возможным получение непрерывной генерации в неполосковых диодах с относительно большой площадью сечения. Проведено изучение режимов работы таких образцов с высокодобротными четырехсторонними резонаторами, а также с плоским резонатором длиной 475 мкм. В таблице

Характеристики непрерывных лазерных диодов.

Таблица.

№№ структурь	Размеры, мкм	Длина волны, мкм	Пороговый ток, мА	Пороговая плотность тока, А/см <sup>2</sup>
1	60·40	1,35	30	1250
2	125·40	1,33	110	1950
3	150·70	1,37	190	1890
—, —	160·90	1,365	180	1250
—, —	405·147	1,377	560	940
—, —	574·98	1,365	400	711
—, —	574·238	1,383	1150	842
—, —	475·137*)	1,38	805	1238

\*) Резонатор Фабри-Перо; остальные диоды с четырехсторонним резонатором

представлены некоторые непрерывные лазеры, полученные четырехсторонним скальванием пластин, ориентированных по плоскости (100). Минимальное значение плотности порогового тока  $j_{th}$  составило  $0,71 \text{ кA}/\text{см}^2$  в непрерывном режиме и  $0,51 \text{ кA}/\text{см}^2$  в импульсном. Наибольшие размеры непрерывного лазера соответствовали площади  $1,37 \cdot 10^{-3} \text{ см}^2$ . В этом образце

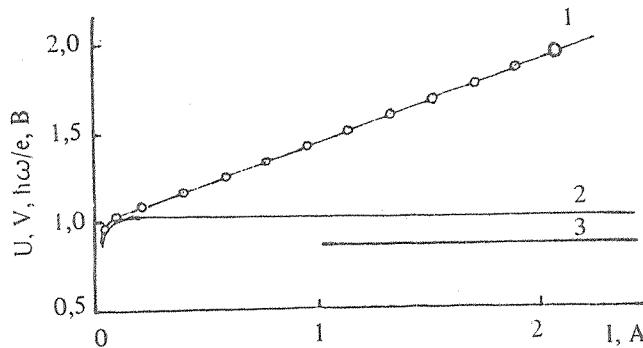


Рис. 1. Вольтамперные характеристики лазерного диода  $U(I)$  (1) и инжектирующего контакта за вычетом падения напряжения в объеме диода  $V(I)$  (2); указанна энергия фотона лазерного излучения  $h\omega/e$  (3)

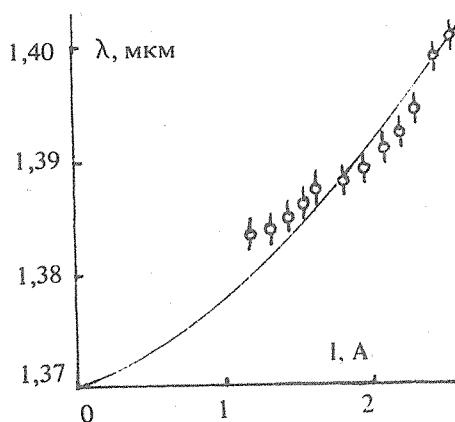


Рис. 2. Спектральная перестройка полосы лазерного излучения в зависимости от тока накачки (тот же диод, что и на рис. 1). Температура окружающей среды 300 K

импульсный порог был равен 0,81 А ( $j_{th} = 592 \text{ A/cm}^2$ ), непрерывный – 1,15 А ( $j_{th} = 842 \text{ A/cm}^2$ ). Это к настоящему времени уникальный пример непрерывного инжекционного лазера при комнатной температуре, и его тепловой режим представляет большой интерес, поскольку генерация наблюдалась в широком диапазоне тока до 2,5 А (рассеиваемая мощность 4,8 Вт). Вольтамперная характеристика показана на рис. 1, где обозначено также положение энергии лазерного фотона  $\hbar\omega$ . Последовательное сопротивление диода равно 0,35 Ом и в основном определяется подложкой р-типа. Напряжение на пороге составило 1,06 В и разность eV –  $\hbar\omega$  достигает 160 мэВ, что примерно соответствует глубине потенциальной ямы в трехслойной волноводной структуре /1/. Спектральная перестройка в зависимости от тока накачки в интервале 1,383 – 1,40 мкм показана на рис. 2. Кривая соответствует расчету с тепловым сопротивлением 10,5 К/Вт (принято значение  $d\hbar\omega/dT = 3,7 \cdot 10^{-4}$  эВ/К /2/). Большую часть этой величины составляет тепловое сопротивление медного держателя и контакта между ним и полупроводником. Использовались двусторонние прижимные держатели с индивидуальными прослойками.

В лазерном диоде с плоским резонатором (типа Фабри-Перо) размером 475·137 мкм порог непрерывной генерации составил 0,8 А (импульсной – 0,6 А).

Авторы выражают глубокую благодарность Л. М. Долгинову и Е. Г. Шевченко за создание исходных гетероструктур.

Поступила в редакцию 21 февраля 1984 г.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. М.Г. Васильев и др.; Квантовая электроника, 11, № 3, 631 (1984).
2. Y. Yamazoe, T. Nishino, Y. Hamakawa, IEEE J. Quant. Electron., 17, № 2, 139 (1981).